

94-0147

Изобретение относится к полупроводниковой технологии и может быть использовано для получения тонких чистых слоев InP с высокими воспроизводимыми электрофизическими параметрами.

Предложенный способ заключается в предварительной термической обработке источника индия и эпитаксиальном выращивании слоев в системе In-PCl₃-H₂, причем, предварительная термическая обработка источника индия осуществляется в вакууме.

Технический результат изобретения заключается в очистке источника индия от неконтролируемых загрязнений и сокращении времени выхода в режим роста слоев InP.

П. формулы: 1